

Avionics Pulsed Power Transistor - 350 Watts, 1030-1090 MHz, 250μs Pulse, 10% Duty



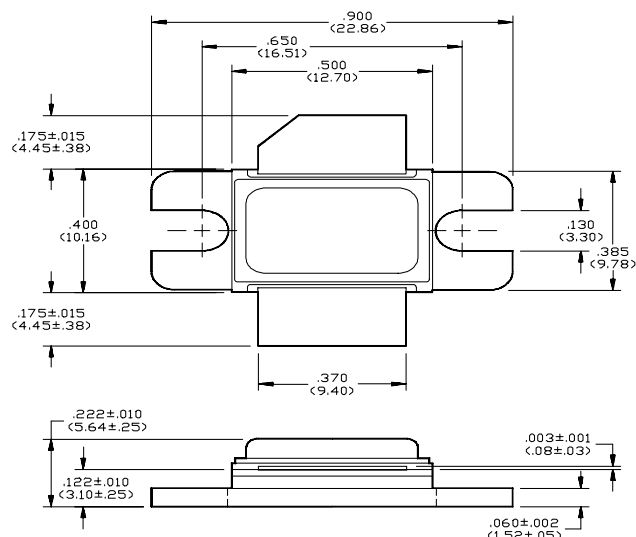
Features

- NPN Silicon Microwave Power Transistor
- Common Base Configuration
- Broadband Class C Operation
- High Efficiency Interdigitated Geometry
- Diffused Emitter Ballasting Resistors
- Gold Metalization System
- Internal Input and Output Impedance Matching
- Hermetic Metal/Ceramic Package

Description

M/A-COM's PH1090-350L is a silicon bipolar NPN power transistor intended for use in L-band, 1.2 - 1.4 GHz avionics equipment such as IFF, mode-S and TCAS systems. Designed for common-base, class C, broadband pulsed power applications, the PH1090-350L delivers 7.5 dB of gain at 350 watts of output power when operating with long pulse length (250μs), at 10 percent duty cycle. The transistor is housed in a 2-lead, rectangular metal-ceramic flange package, with internal input and output impedance matching networks. Diffused emitter ballast resistors and gold metalization assure ruggedness and long-term reliability.

Outline Drawing¹

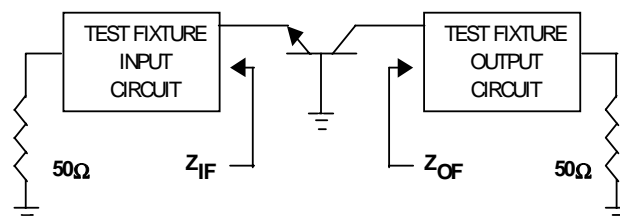


Notes: (unless otherwise specified)

1. Tolerances are: inches ± .005" (millimeters ± 0.13mm)

Narrowband Test Fixture Impedance

F (MHz)	Z _{IF} (Ω)	Z _{OF} (Ω)
1090	2.5 - j1.5	1.1 + j0.9



Absolute Maximum Rating at 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Collector-Emitter Voltage	V _{CES}	80	V
Emitter-Base Voltage	V _{EBO}	3.0	V
Collector Current (Peak)	I _C	17	A
Total Power Dissipation @ +25°C	P _{TOT}	750	W
Storage Temperature	T _{stg}	-65 to +200	°C
Junction Temperature	T _j	200	°C

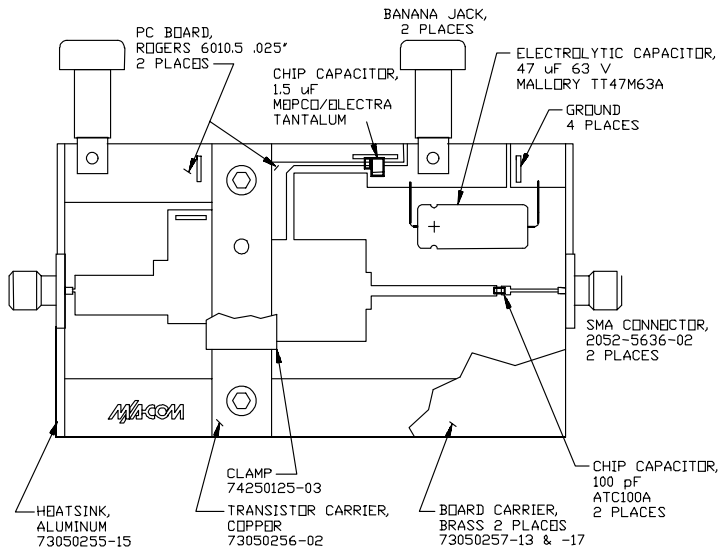
Electrical Specifications at 25°C

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min	Max	Units
BV _{CES}	Collector-Emitter Breakdown	I _C =250mA	80	-	V
I _{CES}	Collector-Emitter Leakage	V _{CE} =45 V	-	25	mA
R _{TH(JC)}	Thermal Resistance	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	-	0.2	°C/W
P _{in}	Input Power	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	-	55	W
G _P	Power Gain	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	8.0	-	dB
η	Collector Efficiency	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	55	-	%
R _L	Input Return Loss	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	9	-	dB
VSWR-T	Load Mismatch Tolerance	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	-	2:1	-
VSWR-S	Load Mismatch Stability	V _{CC} =45 V, P _{in} =350 W, f=1090 MHz	-	1.5:1	-

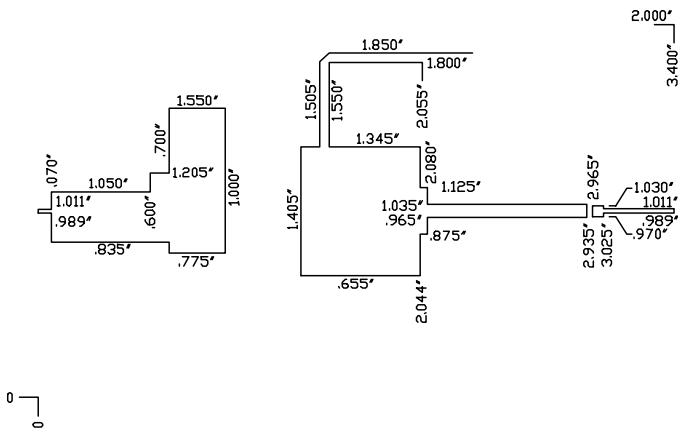
V2.00

Test Fixture Electrical Schematic

Top View



Circuit Dimensions



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru